

Научный совет ОНИТ РАН «Фундаментальные проблемы элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для ее создания»
(научный руководитель — академик РАН Г.Я. Красников)

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

по теме: «Материалы для микро- и наноэлектроники»

Вт. 22 июня 2021 г., здание РАН (г. Москва, Ленинский пр-т, 32А, Синий зал)

- 10:00- академик РАН Красников Геннадий Яковлевич (АО «НИИМЭ»). Открытие
10:10 заседания.
- 10:10- (1) д.ф.-м.н. Рошупкин Дмитрий Валентинович (ИПТМ РАН). Перспективные пьезо-
10:40 и сегнетоэлектрические материалы.
- 10:40- (2) д.т.н. Гамкрелидзе Сергей Анатольевич (ИСВЧПЭ РАН). Плазмохимические
11:10 методы формирования и фрагментирования материалов электронной техники на
примере кубического карбида кремния на кремнии, алмаза и сапфира.
- 11:10- (3) д.т.н. Воротилов Константин Анатольевич (НОЦ «Технологический центр» РТУ
11:40 МИРЭА, РТУ МИРЭА). Доклад находится на согласовании.
- 11:40- (4) д.ф.-м.н. Кукушкин Сергей Арсеньевич, д.ф.-м.н. Осипов Андрей Викторович
12:10 (ИПМаш РАН). Наномасштабный карбид кремния на кремнии и его особые свойства.
От теории до производства.
- 12:10- (5) член-корр. РАН Гудилин Евгений Алексеевич, д.х.н. Зломанов Владимир
12:30 Павлович (МГУ имени М.В. Ломоносова). Принципы управления свойствами
материалов для микро- и наноэлектроники.
- 12:30- (6) д.х.н. Чесноков Сергей Артурович (ИМХ РАН). Новые фоторезисты для
13:00 однофотонной и двухфотонной фотополимеризации.
- 13:00- (7) д.ф.-м.н. Лебедев Александр Александрович (ФТИ им. А.Ф. Иоффе). Графен на
13:30 SiC: получение, исследования и практические применения.
- 13:30- (8) д.х.н. Кецко Валерий Александрович (ИОНХ РАН). Проблемы создания
14:00 материалов и пленочных структур на основе ферритов на подложках
полупроводников для устройств магнитоэлектроники.
- 14:00- (9) к.ф.-м.н. Кобелева Светлана Петровна (НИТУ «МИСиС»). Собственные точечные
14:30 дефекты в соединениях A₂B₆.
- 14:30- (10) к.ф.-м.н. Занавескин Максим Леонидович (НИЦ «Курчатовский институт»
15:00 Доклад находится на согласовании.
- 15:00- (11) к.ф.-м.н. Алмаев Алексей Викторович (Национальный исследовательский
15:30 Томский государственный университет). Элементы силовой и сенсорной
электроники на основе оксида галлия.
- 15:30- (12) к.т.н. Шаповал Сергей Юрьевич, Ковальчук А.В., Полушкин Е. (ИПТМ РАН).
16:00 Материалы радиационно стойкой электроники. Некоторые способы модификации
структур с целью повышения радиационной стойкости.
- 16:00- Общая дискуссия. Подведение итогов заседания Научного совета.
16:15

В пронумерованных пунктах включены 10 минут для ответов на вопросы.

Кофе-брейк организован в фойе с 09:30 до 13:00, посещение в свободном порядке.